
	<h2>SIR882DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR882DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR882DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15652 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SIR882DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15652 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.7 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR882DP-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1930pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 60A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR882DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR882DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR882DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR882DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR880DY-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIR882ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR882DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR882DP VISHAY VISHAY QFN-8</p>
 <p>SIR888DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR880DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR890DP SI SIR890DP SI</p>	 <p>SIR888DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>

SIR882DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR882DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR882DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR882DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR882DP-T1-GE3
SIR882DP-T1-GE3 Electronic	SIR882DP-T1-GE3-Komponenten	SIR882DP-T1-GE3-Verteiler	SIR882DP-T1-GE3-Bild	SIR882DP-T1-GE3-Teil
SIR882DP-T1-GE3 Preis	SIR882DP-T1-GE3 Hersteller	SIR882DP-T1-GE3 Bild	SIR882DP-T1-GE3 Aktie	SIR882DP-T1-GE3 Inventar
SIR882DP-T1-GE3 Neu	SIR882DP-T1-GE3 Original	SIR882DP-T1-GE3 garantiert	SIR882DP-T1-GE3 RFQ	SIR882DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited